

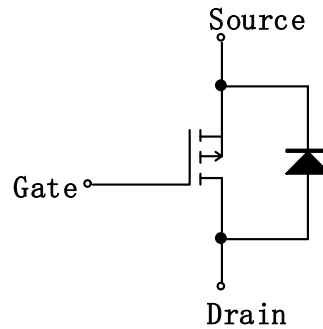
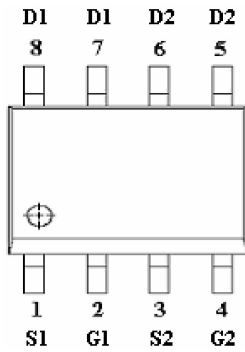
TC4953C (文件编号: S&CIC1071)

20V P 沟道增强型 MOS 场效应管

VDS = -20V

RDS(ON), Vgs@-10V, Ids@-5.3A = 65mΩ@TYP

RDS(ON), Vgs@-4.5V, Ids@-4.2A = 98mΩ@TYP



特点

- 先进的沟道工艺技术
- 高密度超低电阻设计
- 改良的成形工艺

最大额定值和热特性(TA = 25°C, 除非另有说明。)

参数	符号	值	单位
漏源电压	V _{DS}	-20	V
栅源电压	V _{GS}	±12	
漏极电流	I _D	-5.3	A
漏极脉冲电流	I _{DM}	-20	
工作结温和存储温度范围	T _J , T _{stg}	-50 to 150	°C

注：重复性极限值：脉冲宽度由最高结温限制。

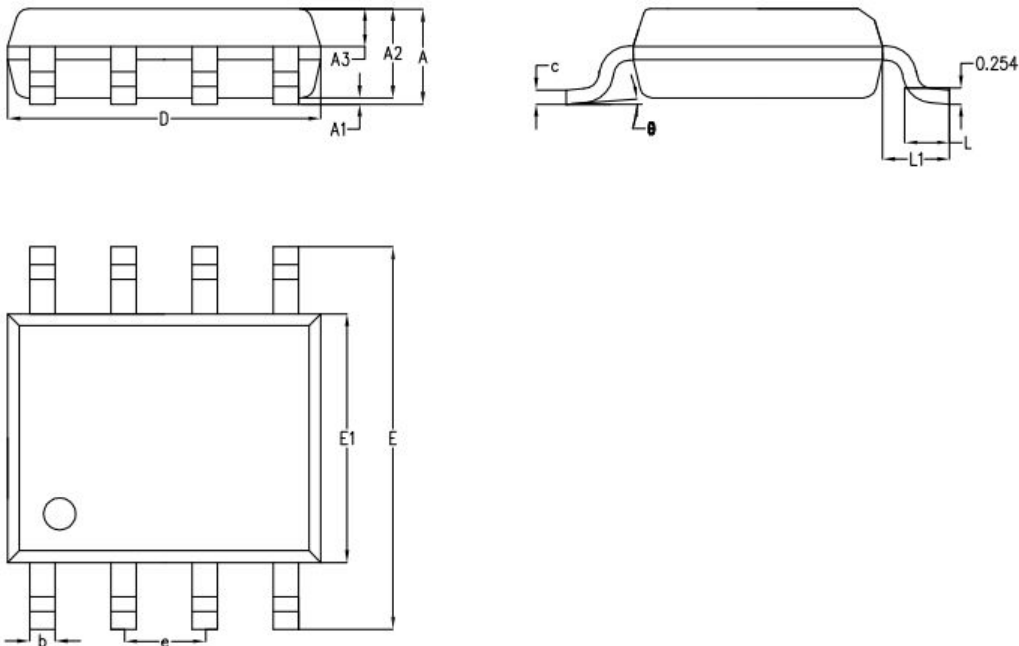
电特性

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
静电						
漏源击穿电压	$B_{V_{DS}}$	$V_{GS} = 0V, I_D = -250\mu A$	-20	--	--	V
漏源电阻	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -4.5V, I_D = -4.2A$	--	90	110	mΩ
	$R_{DS(on)}$	$V_{GS} = -10V, I_D = -5.3A$	--	70	90	
栅极阈值电压	$V_{GS(th)}$	$V_{DS} = V_{GS}, I_D = -250\mu A$	-1	-1.4	-3	V
栅源短路时漏极电流	I_{DSS}	$V_{DS} = -24V, V_{GS} = 0V$	--	--	-1	uA
漏极短路时截止栅电流	I_{GSS}	$V_{GS} = \pm 20V, V_{DS} = 0V$	--	--	± 100	uA
跨导	G_{fs}	$V_{DS} = -10V, I_D = -5.3A$	--	10	--	S
漏源二极管						
二极管最大正向电流	I_S	--	--	--	2.6	A
二极管正向电压	V_{SD}	$I_S = -2.6A, V_{GS} = 0V$	--	--	-1.3	V

注：脉冲测试：脉冲宽度 $\leq 300\mu s$ ，占空比 $\leq 2\%$

封装信息

SOP-8



TC4953C (文件编号: S&CIC1071)

20V P 沟道增强型 MOS 场效应管

符号	毫米		
	最小值	典型值	最大值
A	-	1.50	1.55
A1	-	0.10	0.15
A2	1.35	1.40	1.45
A3	0.55	0.60	0.65
b	0.35	0.40	0.45
c	0.17	0.22	0.25
D	4.85	4.90	4.95
E	5.90	6.00	6.10
E1	3.80	3.90	4.00
e	1.27BSC		
L	0.60	0.65	0.70
L1	1.05BSC		
θ	0°	4°	6°